

Электрические свойства монослоев Cu–O, интеркалированных в кристаллический графит

© В.Ф. Мастеров, А.В. Приходько, О.И. Коньков, А.А. Шакланов

Санкт-Петербургский государственный технический университет,
195251 Санкт-Петербург, Россия

(Поступила в Редакцию 2 сентября 1996 г.)

Исследованы электрические свойства монослоев Cu–O, интеркалированных в кристаллический графит, на сверхвысоких частотах (до 1 GHz) в интервале температур 80–400 K. При повышении температуры выше 300 K сопротивление исходных образцов графита возрастает, что обусловлено десорбцией кислорода. При нагреве образцов с интеркалированными слоями Cu–O в интервале температур 95–130 K наблюдается переход из металлического в полупроводник (или диэлектрическое) состояние. При $T = 8$ K данные образцы обнаруживают микроволновое поглощение, свойственное сверхпроводникам (при $T = 260$ K эффект не регистрируется).

Самопроизвольное проникновение некоторых атомов и молекул во внутреннюю межслоевую область кристаллического графита — интеркалирование — позволяет синтезировать новые анизотропные материалы, важные для многих применений [1]. При этом используется высокоориентированный пиролитический графит (HOPG) [2]. Наряду с интеркалированными атомами (например, меди) на гексагонах графитовых плоскостей могут существовать и атомы другого сорта, например кислорода. В [3] было показано, что при температурах ниже комнатной кислород интеркалирует в графит и при этом играет роль акцептора. При этом в межплоскостном пространстве графита образуются 2D-монослоя Cu–O.

В данной работе приведены результаты исследования проводимости на сверхвысоких частотах кристаллического графита, интеркалированного медью и кислородом, в интервале температур 80–400 K.

1. Образцы и методика

В качестве образцов использовался HOPG размером $10 \times 10 \times 1$ mm. Интеркалирование медью осуществлялось выдержкой HOPG в расплав меди чистоты 9.99% при $T = 1473$ K в течение 20 min в вакууме не хуже 10^{-3} Torr. Интеркалирование кислородом происходило при выдержке образца в течение двух суток на воздухе при комнатной температуре.

Блок-схема измерительной установки представлена на рис. 1. Проводимость измерялась с использованием коаксиального $\lambda/4$ -резонатора на основе симметричной двухпроводной линии внутри круглого экрана с воздушным диэлектриком [4] (рис. 1, b). Для повышения чувствительности метода образец помещался в центр открытого прямоугольного резонатора, изготовленного из меди и термоизолированного снаружи пенопластом. Этот резонатор одновременно играл роль термостата при проведении низкотемпературных измерений.

Коаксиальный резонатор играл роль зонда и мог перемещаться по плоскости образца. При проведении

измерений торец зонда-резонатора приводился в контакт с поверхностью образца. На рис. 2 показаны частотная характеристика сигнала $P(F)$ измерительного блока установки (a) и зависимость P_{\max} от расстояния зонда от поверхности образца h (b).

Для получения количественных результатов проводилась калибровка установки с использованием металлов с известным удельным поверхностным сопротивлением r_s . Зависимость P_{\max} от r_s на частоте 0.84 GHz приведена на рис. 2, c.

Дополнительно проводились измерения проводимости образцов с использованием импульсов напряжения наносекундной длительности по методике, описанной в [5]. Длительность падающего на образец импульса напряжения U_i составляла 4 ns, измерения проводились в конце интервала длительности импульса. Сопротивление образца определялось по формуле

$$R = Z_0(U_i + U_r)/(U_i - U_r),$$

где $Z_0 = 50 \Omega$, U_r — отраженный от образца импульс напряжения.

Температурные измерения проводились в интервале 80–400 K с использованием медно-константановой термопары. Скорость изменения температуры составляет 1 K/min.

2. Результаты и обсуждение

На рис. 3 приведены температурные зависимости P_{\max} для кристаллического графита при двух ориентациях базовой плоскости относительно электрического микроволнового поля: вдоль плоскости (кривая 1) и перпендикулярно ей (кривая 2).

Как видно из этого рисунка, при измерении СВЧ-потерь вдоль плоскости образца P_{\max} уменьшается, а следовательно, сопротивление r_s образца увеличивается (рис. 2, c) при повышении температуры выше 300 K, что совпадает с результатами по десорбции кислорода в порошкообразном графите [3] и фуллерене [6]. Резкий спад при $T \sim 320$ K в данном случае

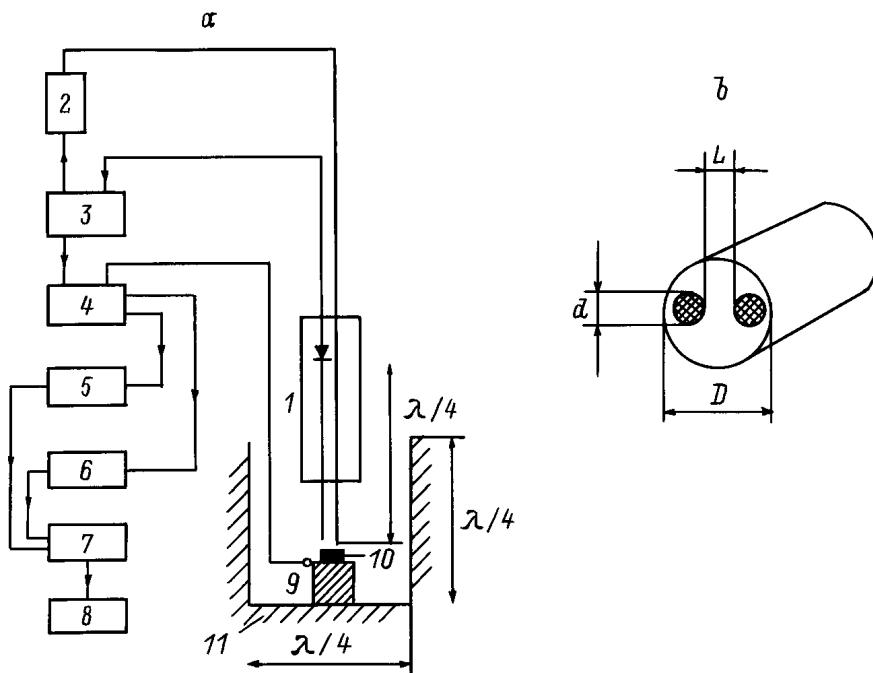


Рис. 1. а) Блок-схема установки: зонд-резонатор (1), согласующий трансформатор 31-46 (2), прибор для исследования АЧХ типа XI-43 (3), самописец Endim 622101 (4), вольтметры В7-21А (5, 6), крейт-контроллер (7), ПК IBM (8), термопары (9), образец (10), прямоугольный резонатор-термостат (11). б) Зонд-резонатор: $D = 1$ mm, $d = 0.16$ mm, $L = 0.5$ mm.

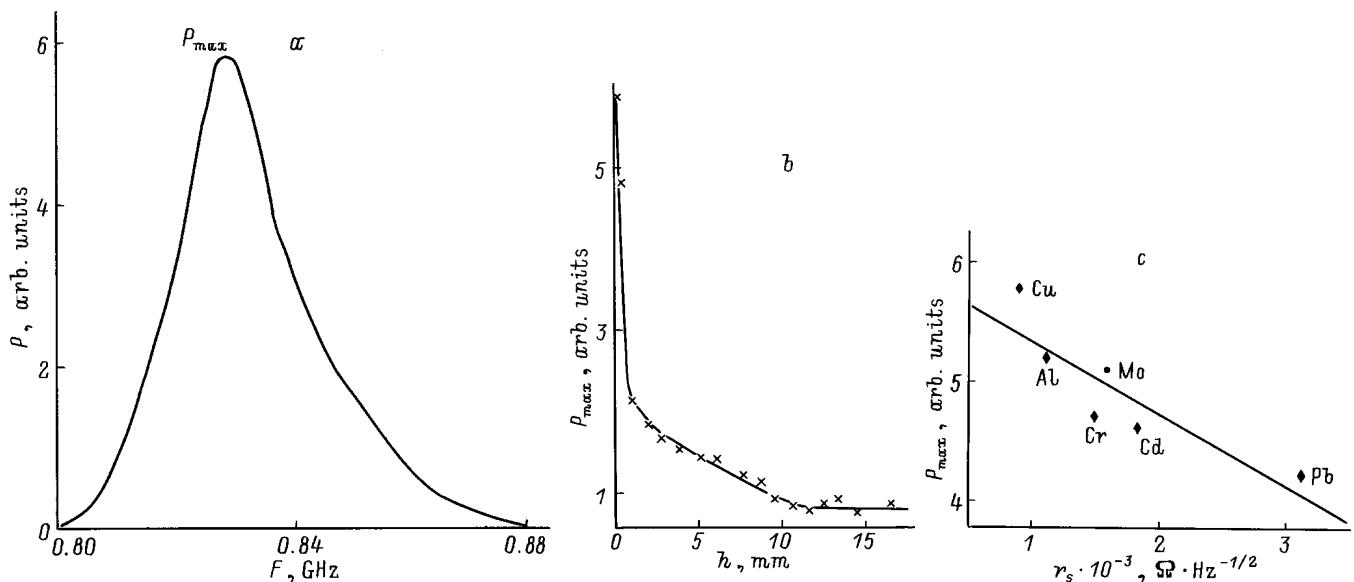


Рис. 2. Зависимость $P(F)$ для Cu (а), P_{max} от h (б) и от r_s для различных металлов (с).

может быть обусловлен увеличением толщины скин-слоя при десорбции кислорода из приповерхностной области образца и проникновением СВЧ-поля в слои, из которых десорбция кислорода затруднена, т. е. в высокопроводящую область образца.

На температурной зависимости поперечной проводимости исходного образца (кривая 2 на рис. 3) особенностей не наблюдается.

Образцы, интеркалированные медью, после приготовления выдерживались на воздухе в течение двух суток. После этого проводилось исследование поверхностного сопротивления по базовой плоскости образца с помощью СВЧ-зонда. При этом в центральной части поверхности кристалла величина поверхностного (на глубине скин-слоя) сопротивления и его температурная зависимость были такими же, как и

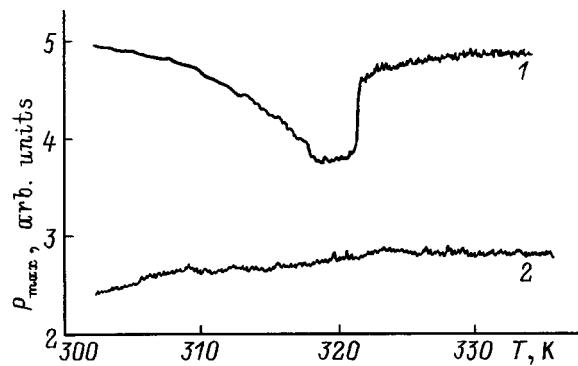


Рис. 3. Зависимость $P(T)$ для исходного HOPG вдоль (1) и поперек (2) базисной плоскости. $F = 1.12$ GHz.

для исходного образца HOPG. Однако по периметру образца его сопротивление на краях не отличалось по величине от сопротивления в центре. Поэтому увеличение сопротивления на краях следует отнести к совместному влиянию меди и кислорода, который, как известно [3], активно интеркалирует в графит при комнатной температуре.

Необходимо помнить, что сразу после приготовления образца его сопротивление на краях не отличалось по величине от сопротивления в центре. Поэтому увеличение сопротивления на краях следует отнести к совместному влиянию меди и кислорода, который, как известно [3], активно интеркалирует в графит при комнатной температуре.

Можно предположить, что медь и кислород химически связываются в межплоскостном пространстве графита, образуя при этом монослои Cu-O, кото-

рые и определяют электрические свойства образцов HOPG:Cu_xO. При этом нельзя исключить влияние p_z -орбиталей атомов углерода в направлениях, перпендикулярных графитовым плоскостям, на свойства образца, поскольку проводимость по π -зоне графита практически исчезает при комнатной температуре и выше.

Наибольший интерес, с нашей точки зрения, представляет температурная зависимость поверхностного сопротивления образца HOPG:Cu_xO в области низких температур. Так, при охлаждении до температуры жидкого азота (77 K) сопротивление образца становится с точностью до погрешности измерения равным сопротивлению исходного образца. При нагреве образца в интервале температур 95–130 K происходит увеличение сопротивления более чем на порядок величины, как это показано на рис. 4 (кривая 1). Повторные измерения температурной зависимости r_s (термоциклирование) приводят к размытию перехода и уменьшению поверхностного сопротивления при низкой температуре (кривые 2–4 на рис. 4). Это может быть связано с проникновением в образец паров воды, поскольку измерения проводились в открытой системе.

Аналогичные зависимости $r_s(T)$ были получены при измерении сопротивления образцов HOPG:Cu_xO с использованием наносекундных импульсов напряжения (рис. 5).

Таким образом, при повышении температуры от 77 K в образцах пиролитического графита (HOPG), интеркалированного медью и кислородом, наблюдается переход из металлического состояния в состояние, которое можно считать по крайней мере полупроводниковым (или диэлектрическим).

Проведенные исследования микроволнового поглощения (9.7 GHz) в нулевых магнитных полях на уста-

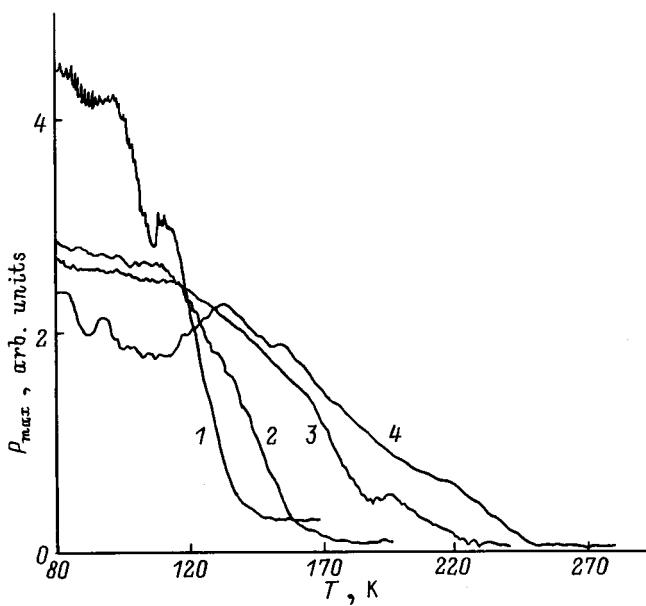


Рис. 4. Зависимость $P_{\max}(T)$ для HOPG:Cu_xO. Кривые 1–4 — термоциклирование в интервале температур 80–270 K.

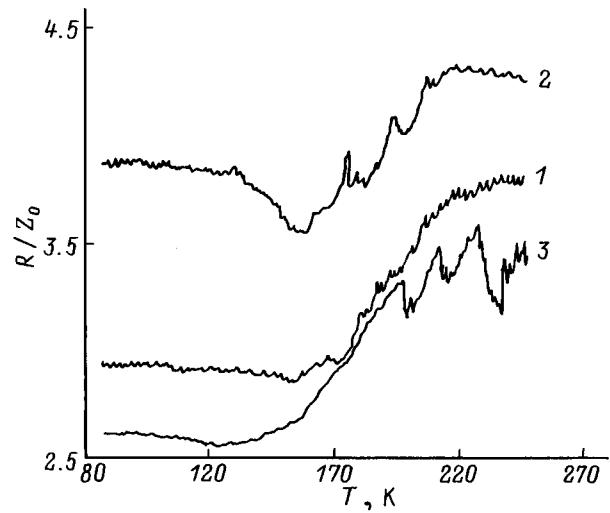


Рис. 5. Зависимость $R/Z_0(T)$ для базисной плоскости образца HOPG:Cu_xO. Кривые 1–3 — термоциклирование в интервале температур 80–270 K.

новке ЭПР выявили при $T = 8$ К наличие электромагнитного эффекта, свойственного сверхпроводящему состоянию [7–9]. При $T = 260$ К данный эффект не регистрируется.

Авторы выражают благодарность К.Ф.Штельмаху за проведение ЭПР-эксперимента.

Работа поддержана Научным советом по направлению "Фуллерены и атомные кластеры" (проект № 94017 "Зона") и Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 96-02-16886а).

Список литературы

- [1] А.Я. Тонтегоде, Е.В. Рутьков. УФН **163**, 11, 57 (1993).
- [2] В.С. Островский, Ю.С. Виргильев, В.И. Костиков, Н.Н. Шипков. Искусственный графит. Металлургия, М. (1986). С. 215.
- [3] В.Ф. Мастеров, А.В. Приходько, Н.И. Немчук, А.А. Шакланов. ФТТ. В печати (1996).
- [4] С.И. Орлов. Расчет и конструирование коаксиальных резонаторов. Сов. радио, М. (1970). С. 231.
- [5] W. Jantson, H. Heinrich. Rev. Sci. Instrum. **41**, 2, 228 (1970).
- [6] H. Werner, M. Wohlers, D. Bublak, Th. Belz, W. Bensch, R. Schlogl. Electronic Properties of Fullerenes / Ed. H.Kusmany, I.Fink, M. Mehring, S.Roth. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (1993). Р. 16.
- [7] Б.И. Шкловский, А.Л. Эфрос. Электронные свойства легированных полупроводников. Наука, М. (1979). С. 263.
- [8] C.J. Asdkins, S.M. Freake, E.M. Hamilton. Phil. Mag. **21**, 175, 183 (1970).
- [9] В.Ф. Мастеров, А.И. Егоров, Н.П. Герасимов, С.В. Козырев, И.Л. Лихолит, В.П. Савельев, А.В. Федоров, К.Ф. Штельмах. Письма в ЖТФ **46**, 7, 289 (1987).